MAKUFACTURE OF QUATERNARY AMMONIUM HYDROXIDE OFHICH PURITY

Patent Number:

JP60131985

Publication date:

1985-07-13

Inventor(s):

TAKAHASHI YUUJI; others: 01

Applicant(s)::

SHOWA DENKO KK

Requested Patent:

☐ JP60131985

Application Number: JP19830238008 19831219

Priority Number(s):

IPC Classification:

C25B3/00; C07C87/30

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain quat. ammonium hydroxide almost free from impurities by dividing an electrolytic cell

into cathode and anode chambers with a cation exchange membrane, feeding an aqueous soln. of quat. ammonium hydroxide to the anode chamber, and electrolyzing it.

CONSTITUTION:An electrolytic cell is divided into cathode and anode chambers with a cation exchange membrane. An aqueous soln. of quat. ammonium hydroxide represented by the formula (where each of R1-R4 is 1-10C alkyl, 1- 10C hydroxyalkyl, 2-10C alkoxyalkyl, aryl or hydroxyaryl) is fed to the anode chamber. Water is fed to the cathode chamber, and the aqueous soln. is electrolyzed to obtain quat. ammonium hydroxide of high purity.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

②公開特許公報(A)

昭60-131985

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)7月13日

C 25 B 3/00 C 07 C 87/30 6686-4K 7118-4H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 3 頁)

❷発明の名称

高純度第4級アンモニウム水酸化物の製造法

到特 顧 昭58-238008

❷出 顧 昭58(1983)12月19日

砂発 明 者 高 橋

佑 - 川道

川崎市川崎区房町5番1号 昭和電工株式会社化学品研究

所内

砂発明者 黒住

忠 利

川崎市川崎区扇町5番1号 昭和電工株式会社化学品研究

所内

切出 顋 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9号

砂代 理 人 弁理士 佐々木 清隆

外3名

剪細 書

1. 発明の名称

高純産第4級アンモニウム水酸化物の製造法

2. 特許請求の範囲

陽イオン交換膜によって陽極室と陰極室に区面 された電解槽を使用して、陰極室に一般式

$$\begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 - N^{\oplus} - R_4 \\ R_3 \end{bmatrix} OH^{\Theta}$$

(式中、R₁, R₂, R₃ およびR₄は同一であつても異なつていてもよく、各々炭素数1~10のアルキル基もしくはヒドロキシアルキル基、またはアリール基もしくはヒドロキシアリール基を扱わす。)で示される第4級アンモニウム水酸化物を搭配室がら第4級アンモニウム水酸化物を得ることを特徴とする高純度第4級アンモニウム水酸化物の製造法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、第4級アンモニウム水酸化物から高 純度第4級アンモニウム水酸化物を製造する方法 に関する。

第4級アンモニウム水酸化物は金属イオンを含 まない強塩基性有機化合物として有用であり、弱 酸の非水溶媒滴定の塩基の標準液として分析に用 いられたり、盗科のピヒクルへの添加剤、シリカ ソル、珪酸アルカリ等の結合剤への添加剤、更に は特殊な洗浄剤及び現像液として電子工業におけ るIC基板の製造等に広く用いられている。特に 最近では後者のフォトレジスト用IC基板の現像 放としての需要が増大しているが、この場合には 純度の高い製品でなければ充分に目的を達するこ とができない。ととろが第4級アンモニウム塩水 溶放を単に電解処理する従来の製造方法によれば 原料由来のアルカリ金属、アルカリ土類金属、ア ニオン頻等の不純物が製品の第4級アンモニウム 水酸化物中に混入しており、このものを例えばポ ジタイプ酸光性樹脂の現像剤および除去剤として 使用すると、不純物である解離した金属イオンが 半導体素子の電気的特性を著しく損なう。

この原料由来の不純物のうち、アルカリ金属、アルカリ土類金属は原料の第4級アンモニウム塩の吟味および精製処理 によつて、目的純度の第4級水酸化物が得られる程度まで減少させることが可能である。しかしながらアニオン類に関しては、上記の処置を行なうことができず、従つてアニオン類が陽極室から陰極室へ移動し、製品の第4級アンモニウム水酸化物中へ温入することは避けられない。

本発明者は高純度の第4級アンモニウム水酸化物を得る方法について鋭意研究の結果、陽イオン交換膜によつて陽極室と陰極室に区画された電解槽を用いて、陽極室に第4級アンモニウム水酸化物水溶液を供給し、陰極室に水を供給して両電極間に直流電流を通電することにより陰極室から高純度第4級アンモニウム水酸化物が得られることを見出し、本発明を完成するに至つた。

本発明においては、陽イオン交換膜としてスル

アルキル基もしくはヒドロキシアルキル基、炭素数2~10のアルコキシアルキル基、またはアリール基もしくはヒドロキシアリール基を表わす。) で示されるものである。

具体例としては式中のR,~R,が、メチル、エ チル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、 ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル基およびと れらのヒドロキシ勝導体;メトキシ、エトキシ、 プロポキシまたはブトキシ基で置換されたメチル、 エチル、プロビル、プチルまたはペンチル基;フ エニル、ペンジル、フエネチル基およびそれらの 基中のペンゼン環がヒドロキシ基で置換された基 を表わしている、例えば水酸化テトラメチルアン モニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、水 酸化トリメチルエタノールアンモニウム、水酸化 トリメチルメトキシアンモニウム、水酸化ジメチ ルジメトキシアンモニウム、水酸化ジメチルジエ タノールアンモニウム、水酸化メチルトリエタノ ールアンモニウム、水酸化テトラエダノールアン モニウム、水酸化ペンジルメチルジエタノールア

フォン酸基、カルボン酸基等の陽イオン交換基を 有するスチレン - ジビニルペンゼン共重合体膜お よびフッ素樹脂膜等が使用される。

電極を構成する材料としては、陽極は無4級アンモニウム塩の電解により発生する酸素等に対して耐久性のある安定なものがよく、鉛、鉛合金、各種金属に白金族金属を被優した電極を用いるのが適当である。また陰極用材料は陽極の場合ほど化学的安定性は要求されず、例えば鉄、ニッケル、コパルト、カーボンおよびこれらの合金で足りる。勿論、陽極用に挙げた白金族系被模電極等を用いてもよい。

観解槽の陽極量に水溶液として供給される第4 級アンモニウム水酸化物は、一般式

$$\begin{bmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_2 - N \oplus - R_4 \\ \vdots \\ R_3 \end{bmatrix} OH^{\Theta}$$

(式中、 R_{1} , R_{2} , R_{3} および R_{4} は同一であつて も異なつていてもよく、各々炭素数 $1 \sim 10$ 個の

ンモニウム、水酸化フエニルトリメチルアンモニ ウム、水酸化フエニルトリエチルアンモニウム、 水酸化ペンジルトリメチルアンモニウム、水酸化 ペンジルジメチルフエニルアンモニウム等がある。

これらの第4級アンモニウム水酸化物は、3~ 50重量多の過度で用いられる。3重量多未満で は液電気抵抗の増加が認められ、50重量多以上 では液粘度の増加が電解上で問題となつてくる。

また、電解反応においては液温を50℃以下に保つようにすべきである。50℃以上になると陽極液の腐食性が上昇し、また陰極液では目的物が分解し、アンモニア臭のある煙を発生するので好ましくない。

また前配陰極室には水を供給して電解反応を開始するが、通電当初より電解電圧を低下させるために少量の目的生成物である第4級アンモニウム水酸化物を予め級加しておくことが好ましい。

電解に際しては電流密度 $1\sim 100\,\mathrm{A/dm^2}$ 、好ましくは $10\sim 50\,\mathrm{A/dm^2}$ の条件で直流電圧を印加する。このような電解条件によつて陰極室か

特間昭60-131985(3)

ら原料由来のアルカリ金属、アルカリ土類金属、アニオン等の不純物の混入量の極めて少ない高純 度の第4級アンモニウム水酸化物を得ることができる。

次に実施例により本発明を脱明する。

奥施例 1

イオン交換膜として、Nafion 901 (デニポン社製、フツ素樹脂系陽イオン交換膜)を使用して電解槽を陽極窟と陰極窟に区画し、陽極として白金被積極、陰極としてニッケル板を用い、陽極室に水酸化テトラメチルアンモニウムの20.5重量が水溶液を供給し、液温30℃、20A/dn²の条件で直流電圧を印加して電解を行ったところ、電解電圧6.8~12 V、電流効率88%にて陰極窟から水酸化テトラメチルアンモニウムの19.8 重量が水溶液が得られた。電解的および電解後のテトラメチルアンモニウム水酸化物水溶液の含有金属量および含有塩素イオン、硫酸イオン量は以下のとおりであった。

	電解前	電解後
Nα	0.050mg/8	0.0 5 0mg/B
K	0.0 5 0	0.040
Ca	< 0.0 1	< 0.0 1
Mg	<0.005	<0.005
F e	0.0 1	<0.01
Cu	< 0.0 1	<0.0 1
P b	0.0 0 1	0.0 0 1
Z n	0.0 0 1	0.0 0 1
C &	8 0	0.6
SO4	0.5	<0.1

代 理 人 弁理士(8107)佐々木 清 隆 (はか3名)